PRESENT STATUS OF THE KEK ELECTRON/POSITRON INJECTOR LINAC

Y. Ogawa¹ for the electron/positron injector group KEK, High Energy Accelerator Research Organization, Accelerator Laboratory 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801

Abstract

The KEK electron/positron injector linac has been continuously operating for about ten months a year without any long shutdown, repeating frequent injections into four different rings (KEKB-LER/HER, Photon Factory-PF/AR). In January 2003, KEKB has started a continuous injection mode (CIM), in which keeping stored currents almost constant in both rings, the integrated luminosity of KEKB has been considerably improved by nearly 30 %. The CIM, however, imposes severe conditions on the injector linac concerning time for beam tuning and hardware maintenance to assure the high beam quality. Issues on linac operation and statistics in these situations are reported as well as various improvements carried out over a year. R&D activities including a future upgrade for SuperKEKB are also presented.

KEK電子・陽電子入射器の現状

1. はじめに

KEK電子・陽電子入射器では、一昨年秋からの KEKB陽電子2バンチ入射に引き続き本年1月からは KEKB連続入射を常時実施している。その結果KEKB における一日当りの積分ルミノシティが20-30%増加 し、加速器として1/fb/dayをBelle(物理実験)に供給 するまでに至っており、今や連続入射は KEKBの ようなルミノシティマシンにおいて必須の技術と なっていると言えよう。一方、入射器としてはビー ム調整、機器の保守時間がほとんどとれないまま ビームを出し続けており、このような状況でのビー ム性能維持とそれを支えるハードウェアの信頼性の 確保が、最重要課題となっている。

また、KEKB連続入射は入射器がビームを供給し ている他のリングとのビームの取合いについて深刻 な問題を投げかけている。他リングでは定期的な入 射(日に1-2回)時以外に、ビーム性能改善のための マシンスタディを連続した時間実施するのが非常に 困難になってきた。そこで、KEKB、PF、AR同時入 射(正確にはパルス毎入射)を実施するべく検討が 開始された。

以下、昨年から現在までの運転と統計、ビーム性 能維持とハードウェア等改善、KEKB連続入射に関 する問題点とKEKB、PF、AR同時入射を含めた今後 の展望について報告する。また、2004年度から本格 的にユーザー運転を開始した低速陽電子実験用テス トリニアックの運転の現状について概説する。

2. 運転と統計

2.1 ビーム品質管理と維持

KEKB連続入射が始まった結果、入射中に物理の

検出器やリングのビーム蓄積状態に影響を与えずに リニアックのビーム調整を実施しなければならなく なった。ビーム性能維持のためのビーム軌道、エネ ルギー幅などの調整においては陽電子発生用一次電 子ビームの場合は直接リングの蓄積ビームに影響を 与えないので必要に応じて入射中に実施^[1]している が、電子ビームの入射中の調整は基本的に難しい。 そのような場合におけるビーム調整のために、これ までにエネルギー幅測定用非破壊モニタとして8電 極位置モニタを導入してきたが、本年からこれを用 いたエネルギー幅最適化フィードバックの試験運用 ^[2]を開始した。一方、従来入射部付近から時々異常 軌道が発生しビーム性能が著しく悪化する現象が見 られるが、その原因究明^[3]も進んでいる。

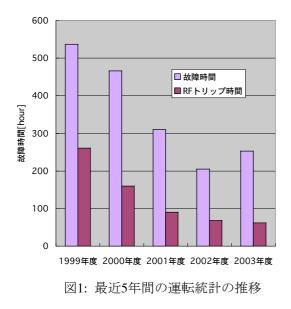
2.2 運転統計

2003年度の入射器運転においては、2004年1月から開始されたKEKB連続入射によるビーム入射時間の増大に伴う影響が懸念されたが、今のところ直接的な故障率の上昇はなさそうである。表1に2003年度運転統計を、図1には最近5年間の運転統計の推移を示す。故障率がやや横ばいとなっているが、まだ統計が少ないので連続入射の影響と見るよりはむしろ老朽化の問題と捉えるべきかもしれない。全体的には入射器の運転は例年通り概ね安定であった。

表1:2003年度運転統計

総運転時間	6,815 時間
マシンダウンタイム	253 時間 (3.7 %)
ビームロスタイム	27 時間(0.40 %)

¹ E-mail: yujiro.ogawa@kek.jp



3. 維持、改善

3.1 rf系

KEKB連続入射による直接的な影響を最も強く受けたのがff系の維持、改善に関わる仕事である。従来から続けているクライストロンアセンブリ、サイラトロン、ff窓の運転統計^[4]を更に有効に利用し故障、交換等の目安をたてているだけでなく、ff波形、電力、位相のモニタデータを効率的に取込むためにデータ収集系の自動化^[5]を進めている。

このような対策に加えて昨年度試験に成功したク ライストロンのディップテスト¹⁶を定期的にクライ ストロン全数で実施し、クライストロンの寿命の推 定を行い夏期シャットダウン等での交換予定に役立 てている。実際に全数(約60台)のディップテスト を実施するためには、KEKB連続入射の合間(リン グ不調時、他のエネルギーの低いリングへの入射時 など)を利用するだけでは時間が足りないので、こ の春から入射器の隔週のメンテナンス日にrfオンメ ンテナンス時間を組入れて、その時間(毎回2時間 程度)に行うようにしている。

3.2 加速管

入射器にはすでに20年以上使用し続けている加速 管が多く老朽化が進み、たとえば加速管の冷却水路 からの大きな水漏れが発生する場合がある。このよ うな場合でも、KEKB連続入射をできる限り妨げな いように水漏れを短い時間に抑制するなどの工夫を 凝らしている。最近発生した水漏れでは、船舶用の マルチメタルという水漏れ対策用物質を使用して水 漏れ量を短時間に大幅に減少^円させることができた。

加速管の放電についてはトリップ時にクライスト ロンのパワーを一時的に下げて放電を抑え入射を継 続しつつ、またパワーを徐々に回復させるという、 きめの細かい対応で重大な事態に至らないようにし てきた。トリップの絶対数が少ないので、このよう な人的な方法によって安定運転が維持されているが、 より高電界加速を実現する場合はトリップ数も増え るので然るべき自動化が必要となると考えられる。 そこでCバンド高電界加速試験(アップグレードの 章参照)に合わせて、加速管エージング中の放電発 生時に自動的にrfのパルス幅狭める仕組み^{[8], [9]}を開 発した。

3.3 制御系

制御系においても周辺機器の老朽化による運転障害の発生は避けられない。入射器では従来頻繁に使用してきた運転用タッチパネルシステムの老朽化が進み維持/保守が困難となったため、機能向上を目指してX-window上にオペレータインターフェースを開発^[10]した。その結果、従来の機能維持だけでなく新しい機能の追加も容易に行えるようになり既に運転に頻繁に使用されている。

同様なことはネットワーク機器にも当てはまるが、 この場合国際標準化を目指せば新しい機器の導入が 容易になりシステムの信頼性が向上すると期待され る。このような試み¹¹¹¹は、KEKB連続入射時にビー ム性能を更に安定化するフィードバックループを追 加する場合等にとくに威力を発揮すると思われるの で、現在検討を進めている。

3.4 真空系

加速管内のフィールドエミッション等の影響でス クリーンモニタ用の覗き窓が帯電・放電し真空リー クを引起こすことがある。通常真空用の塗布材を塗 りリークを抑えるが、場合によってはリークが止ま らないことがある。そのような場合の対策として塗 布材ではなく真空ジャケット方式¹²¹を考案し、実際 のリーク箇所に装着し経過を監視している。この方 法は短時間で実施可能なのでKEKB連続入射のため 長時間真空作業ができない状況に適した方法である。

4. 低速陽電子用リニアック

低速陽電子実験施設では2003年度秋から本格的な 実験^{[13],[14]}が始まり、低速陽電子用リニアックの運 転はPFの実験スケジュールに従い24時間連続運転を 行っている。入射器のオペレータはビームの状態監 視、ビームON/OFF、ハードウェア点検、安全確認 等を実施している。

5. R&D

5.1 結晶標的を用いた陽電子生成実験

高品質な陽電子ビームを効率的に得るために、結 晶におけるチャネリング放射によって発生する大量 のフォトンを金属標的に照射して陽電子を生成する 実験^[15]を行っている。2003年度はフォトン放出率の 大きいダイヤモンドとシリコンの単結晶を使用した が、これまでの結果からは絶対的な陽電子発生量は タングステン単結晶に劣るようである。

5.2 カーボンナノチューブを用いた電子銃の開発

低エミッタンスビーム実現のため、カーボンナノ チューブを冷陰極とするフィールドエミッション型 電子銃の開発¹¹⁶を進めている。これまでに加速電圧 100 kV、数十ナノ秒、ピーク電流0.1 Aのビーム加速 に成功している。更に各種改善を進めれば1Aを越え るビーム加速が期待される。

5.3 GLCTA(Global Linear Collider Test Accelerator)開発

リニアコライダー計画のためのrf源に関する系統的なR&D^{III}を行っているが、この一年でより実機に近い形での試験加速器システムの構築が進んだ。

6. アップグレード

6.1 KEKB、PF、AR同時(パルス毎)入射

KEKB連続入射の効率向上のためには、入射器が ビームを供給している他のリングへの入射を同時 (パルス毎)に行えるようにする必要がある。これ が実現できれば、他のリングにおいて入射を連続的 に行うマシンスタディも自由に行えるようになる。 そのためには入射器としてはパルス毎に異なるエネ ルギー、電荷量のビームを加速しなければならない。 方法としてはバイパスライン案と共通のオプティク スで異なるエネルギーを加速する案の二つを主とし て検討してきた。後者については、実際に現在のリ ニアックを用いてビーム試験⁽¹⁸⁾を進めている。これ までのところ、適当なエネルギーに最適化したオプ ティクスを用いれば異なるエネルギーのビームが加 速可能であることが示されたが、ビーム品質につい て検討を進めているところである。

一方、KEKBが陽電子入射時は陽電子標的が挿入 されるが、この操作は機械的なものでパルス毎に行 うことはできないので標的からの2次電子ビームの 加速(PF, AR用)を検討している。これまでの加速 試験によれば陽電子ビームと同等の品質が得られる ことが確認されたが、標的直後の加速位相を調整す ることによって所謂「速度集群」を実現しエネル ギー幅やエミッタンスの改善を目指したい。

6.2 SuperKEKBのためのCバンド加速システム

SuperKEKBでは陽電子ビームの入射エネルギーを 3.5 GeVから8 GeVに高くすることが要請されている。 陽電子標的からリニアック終端までの距離が限られ ているので加速利得を倍増することによってエネル ギー増強を実現する。そのために一昨年来Cバンド 加速システムの開発を進めているが、今回、加速管 1号機での長期rf運転、加速試験、rfパルス圧縮器お よび改造型加速管2号機^[19]の製作、rf窓の高電界試験 ^[20]などについて大幅な進展があった。今後、最終的 な構成に近いシステムでの加速試験を行う予定である。

参考文献

- [1] 花村幸篤 "KEK電子陽電子入射器における高品 質ビーム維持"、These proceedings.
- [2] 佐藤政則 "8電極非破壊モニタによるエネルギー 広がり計測"、These proceedings.
- [3] 諏訪田剛 "電流モニター用セラミックダクトの 結合インピーダンスの評価"、These proceedings.
- [4] 今井康雄 "KEK 電子陽電子ライナックにおける 高周波源の維持管理"、These proceedings.
- [5] 片桐広明 "KEK電子陽電子入射器のRFデータ収 集"、These proceedings.
- [6] 中尾克巳 "電子、陽電子ライナックにおける大 電力クライストロンディップ試験の結果"、 These proceedings.
- [7] 池田光男 private communication.
- [8] 池田光男"リアルタイムRFパルス短縮用トリガ システム"、These proceedings.
- [9] 矢野喜治"リアルタイムRFパルス圧縮システム"、These proceedings.
- [10] 工藤拓弥 "KEK電子LINACにおける仮想タッチ パネルシステムの開発"、These proceedings.
- [11] 古川和朗"加速器制御のためのネットワーク接 続機器の開発"、These proceedings.
- [12] 柿原和久 private communication.
- [13] 栗原俊一 "高強度低速陽電子ビームを用いた NEG表面からのポジトロニウムTOFスペクト ル"、These proceedings.
- [14] 草野史郎 "KEK低速陽電子施設における高速波 形収集及び解析システムの開発"、These proceedings.
- [15] 諏訪田剛 "8 GeV電子ビームによるシリコン及 びダイヤモンド結晶標的を用いた陽電子生成実 験"、These proceedings.
- [16] 穂積康文 "カーボンナノチューブ冷陰極を持つ フィールドエミッション電子銃の開発"、These proceedings.
- [17] 福田茂樹 "GLCTAにおけるRF源のR&D計画"、 These proceedings.
- [18] 大西幸喜 private communication.
- [19] 紙谷琢哉 "SuperKEKB計画の為のKEK電子陽電 子ライナックのCバンド化R&Dの現状"、These proceedings.
- [20] 竹中たてる "Cバンドレゾナントリングを用い た高周波窓の大電力試験"、These proceedings.